

# 第9回国際ナノテクノロジー会議 (INC9) 開催報告

電子デバイス部



INC (International Nanotechnology Conference on Communication and Cooperation) は、日米欧のナノテクノロジー政策立案者、研究者、企業のキーパーソンが集まり、ナノテクノロジーの最新動向・将来の方向について議論し、国際的な協力・交流を推進する国際会議です。

INC は、日米欧の持ち回りで、年1回開催されてきており、INC9はドイツのベルリンで開催されました。参加者は155名で、うち我が国からは、内閣府、文部科学省、経済産業省の他、産学等から45名の参加がありました。

JEITA 半導体技術委員会 INC-WG (国際ナノテクノロジー会議ワーキンググループ) は、オーガナイザー参画機関の一つとして、INC9の企画・運営に積極的に貢献しました。

講演者として JEITA から推薦した下記の方々 (講演順) は、最新の成果を披露し、いずれも会場の注目を集めました。



コーヒープレーク中の交流

- ・齋藤真澄氏 (東芝) [High-Performance Silicon Nanowire MOSFETs for Ultra-Low Power LSI]
- ・福田浩一氏 (AIST) [HyENEXSS: Computing Device Design and Characterization Platform for Nanoelectronics]
- ・賣野豊氏 (PETRA) [High Density Optical Interconnects by Using Silicon Photonics]

今回の基調講演は、ヘムニッツ大学 (独) T. Seyller 教授による [Epitaxial Graphene - from Flakes to Wafers] と題するグラフェンに関する講演でした。昨年 (INC8) は、飯島純男氏によるナノカーボン材料に関する基調講演であり、2年続けてカーボンについての基調講演となりました。これは世界の関心材料の一つがカーボン系であることを反映しているものと思われます。



講演風景

他には、日米欧3極のナノテクノロジー研究開発分野、たとえば「Bridge to Materials」分野において、日米欧の最先端研究開発に関する議論を行いました。

またポスターセッションも併催され、3日目の一般ポスターセッションでは、日17件、米15件、欧31件の合計63件の展示があり、

活発なセッションとなりました。これら63件から、ベストポスターアワード1件(日(NIMSの研究者))、ポスターアワード2件(欧米各1件)が表彰されました。

INC9のその他の結果を含む概要は以下の通りです。

1. **会議名称** : The Ninth International Nanotechnology Conference on Communication and Cooperation (INC9)
2. **開催期間** : 2013年5月14日(火)～17日(金)
3. **開催場所** : Frunhofer Forum Berlin (ドイツ、ベルリン)
4. **参加者数** : 155名
5. **参画機関** : 日本 : (独) 物質・材料研究機構 (NIMS)、(独) 産業技術総合研究所 (AIST)、一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)、(社) ナノテクノロジービジネス推進協議会 (NBCI)  
米国 : CNSI, DOD AFOSR, NIST, NSF, SEMATECH, SIA, SRC  
欧州 : European Commission, CEA/LETI, Fraunhofer, IMEC, ENIAC
6. **Website** : <http://www.inc9.de/>

次回 (INC10) は、2014年5月13日(火)～16日(金)に米国ワシントン D.C. 近郊の NIST で開催予定です。  
(Website: <http://www.inc10.org/>)